

Spezifikationen	
Artikelnummer	BC847BVN,115
Hersteller	Nexperia
Beschreibung	TRANS NPN/PNP 45V 0.1A SOT666
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	2578 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	45V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 5mA, 100mA
Transistor-Typ	NPN, PNP
Supplier Device-Gehäuse	SOT-666
Serie	Automotive, AEC-Q101
Leistung - max	300mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	100MHz
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	200 @ 2mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	15nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

sein:

BC847BVC
DIODES



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

BC847BW H6327
INFINEON
BC847BW H6327 INFINEON

nexperia

BC847BVN ,115
NEXPERIA
NEXPERIA/ New



YIC International Co., Limited.

Not Actual Photo

BC847BVN NXP



YIC International Co., Limited.

Not Actual Photo

BC847BW NXP/Nex



nexperia

BC847BVN.115
NEXPERIA
NEXPERIA SOT

Mehr